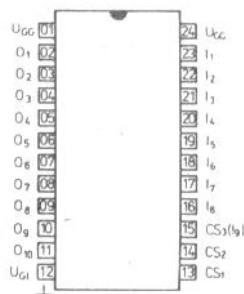


STATICKÁ PEVNÁ PAMĚT ROM S KAPACITOU PAMĚTOVÉ MATICE
2560 BITŮ — MŮŽE PRACOVAT V ORGANIZACI 256 SLOV
PO 10 BITECH NEBO 512 SLOV PO 5 BITECH.

V PAMĚTOVÉ MATICI JE ULOŽENA INFORMACE O 64 ALFANUMERICKÝCH ZNACÍCH, ROZLOŽENÝCH DO RASTRU 5 × 7 BODŮ. VSTUPY A VÝSTUPY PAMĚTI JSOU SLUČITELNÉ S OBVODY TTL A DTL.

MHB2501, MHB2501A GENERÁTOR ALFANUMERICKÝCH ZNAKŮ V LATINSKÉ ABECEDĚ — KÓD ZNAKŮ ASCII ODPOVÍDÁ NORMĚ ČSN 36 8802, RVHP RS 2175—69.

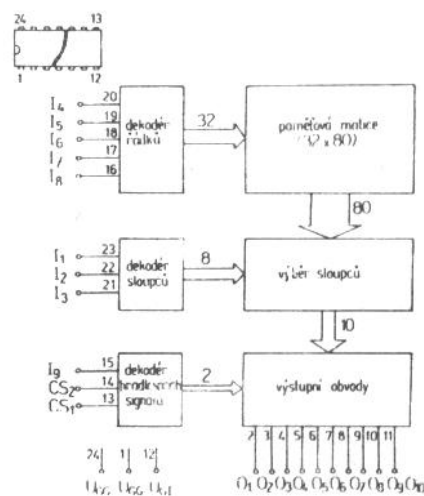
MHB2502, MHB2502A GENERÁTOR ALFANUMERICKÝCH ZNAKŮ V RUSKÉ ABECEDĚ — KÓD ZNAKŮ ODPOVÍDÁ NORMĚ RVHP RS 2175—69.



Zapojení vývodů (pohled shora)

MEZNI HODNOTY:

	min.	max.	V
$U_{CC/CC}$	-20	+0,3	V
$U_{CC/GI}$	-10	+0,3	V
$U_{CC/II}$	-10	+0,3	V
P_{tot}		800	mW
θ_a	0	+70	°C
θ_{stg}	-55	+155	°C



Pouzdro IO 15/1

Blokové zapojení obvodů

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: $\theta_a = 0 \dots +70^\circ\text{C}$

Svodový proud vstupu $-U_I = 5\text{ V}$	$-I_I$	< 1,0	μA
Vstupní napětí — úroveň L $U_{CC} = +5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$, $U_{GG} = -12\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$, $U_{GI} = 0\text{ V}$	U_{IL}	< 1,0	V
Vstupní napětí — úroveň H $U_{CC} = +5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$, $U_{GG} = -12\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$, $U_{GI} = 0\text{ V}$	U_{IH}	> 3,5	V
Kapacita vstupu $U_{CC} = +5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$, $U_{GG} = -12\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$, $U_{GI} = 0\text{ V}$, $U_I = U_{CC}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_I	< 10	pF
Výstupní napětí — úroveň L $U_{CC} = +5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$, $U_{GG} = -12\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$, $U_{GI} = 0\text{ V}$, $I_{OL} = 3,2\text{ mA}$	U_{OL}	< 0,8	V
Výstupní napětí — úroveň H $U_{CC} = +5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$, $U_{GG} = -12\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$, $U_{GI} = 0\text{ V}$, $I_{OH} = -0,2\text{ mA}$	U_{OH}	> 3,5	V
Svodový proud výstupu $U_{CC} = +5\text{ V} \pm 0,25\text{ V}$, $U_{GG} = -12\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$, $U_{GI} = 0\text{ V}$, $U_O = U_{GI}$, $U_{\bar{O}} = U_{CC}$	$-I_O$	< 1,0	μA
Zpoždění výstupu $U_{CC} = +5\text{ V}$, $U_{GG} = -12\text{ V}$, $U_{GI} = 0\text{ V}$, $\theta_a = +25^\circ\text{C}$, zátěž jeden logický člen NAND TTL, $C_L = 15\text{ pF}$ MHB2501, MHB2502 MHB2501A, MHB2502A	t_p t_p	< 0,6 < 1,0	μs μs

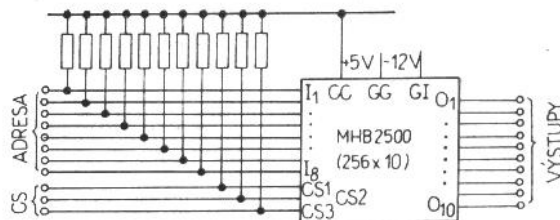
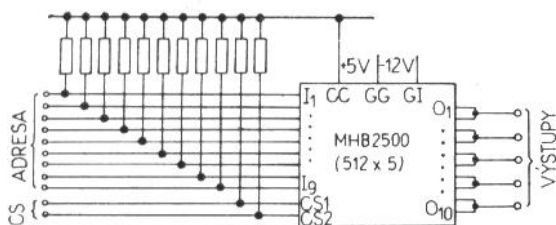
Informativní hodnoty: $U_{CC} = +5\text{ V}$, $U_{GG} = -12\text{ V}$, $U_{GI} = 0\text{ V}$, $\theta_a = +25^\circ\text{C}$

Odběr proudu ve statickém provozu	I_{CC} I_{GG}	22 22	mA mA
Šumová imunita bez zátěže	U_N	1,0	V

DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ PEVNĚ PAMĚTI PRO JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE

ORGANIZACE: 512 slov po 5 bitech

256 slov po 10 bitech



OBSAH PEVNĚ PAMĚTI

MHB2501
MHB2501A

Výstupy jsou aktivní při nastavení signálů CS₁ = H, CS₂ = L.
Řádek č. 8 (I₁ = I₂ = I₃ = H) není využit.

CS1	I4	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L	H	H
H	I5	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L	L	H	H	H	H
CS2	I6	L	L	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H
L	I9	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H
I7	I8	L	L														
L	L																
H	L																
L	H																
H	H																

MHB2502
MHB2502A

Výstupy jsou aktivní při nastavení signálů CS₁ = L, CS₂ = H.

CS1	I4	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L	H	H	L	L	H	H
L	I5	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L	L	H	H	H	H
CS2	I6	L	L	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H
H	I9	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H
I7	I8	L	L														
L	L																
H	L																
L	H																
H	H																

Tmavá pole označují výstupy ve stavu úrovně H.

Typ	Druh	Pouzdro
MHB1902 MHB1902C	Statická paměť CMOS RAM 1024 × 1 bit, organizace paměťové matice 64 řádků po 16 buňkách, vstup a výstup dat je oddělen, výstup třístavový hradlovaný signálem CE. Provoz pro uchování informace vyžaduje napájecí napětí min. 2,5 V. Typ MHB1902C je v keramickém pouzdru.	IO—18 IO—18/C
MHB2102 MHB2102/2	Statická paměť NMOS RAM 1024 × 1 bit, organizace paměťové matice 32 × 32, vstup a výstup dat je oddělen, výstup třístavový aktivovaný signálem CE.	IO—14A
MHB2114	Statická paměť NMOS RAM 1024 × 4 bity s polykrystalickým hradlem, organizace paměťové matice 64 × 16, vstup a výstup dat je společný, výstup třístavový. Systém obsahuje vnitřní blok generátoru předpětí substrátu, pracujícího na principu nábojové pumpy (Charge Pump), který je připraven k provozu asi 500 μs po připojení napájecího napětí U _{CC} .	IO—18/1
MHB2500 řada	Statické pevné paměti ROM 2560 bitů, vyrobené technologií MNOS na křemikové podložce typu N s tranzistory s kanálem P; mohou pracovat s organizací 256 slov po 10 bitech nebo 512 slov po 5 bitech. Výstupy třístavové, hradlované signálem CS. Organizace, obsah paměti a nastavení signálů CS se vkládají během výroby přepojovací maskou.	IO—15/1
MHB2501 MHB2501A	Generátor alfanumerických znaků v latinské abecedě; kód znaků ASCII odpovídá ČSN 36 8802, RVHP RS 2175-69. Organizace paměti 512 × 5, matice znaku 5 × 7.	
MHB2502 MHB2502A	Generátor alfanumerických znaků v ruské abecedě; kód znaků odpovídá normě RVHP RS 2175-69. Organizace paměti 512 × 5, matice znaku 5 × 8.	
MHB2503	Převodník sedmibitového kódu ISO/7 na dálnopisný kód CCIT2 nebo CCIT2 na ISO/7. Organizace 256 × 10.	
MHB4116 MHB4116C	Dynamická paměť NMOS RAM 16 384 × 1 bit s paměťovou maticí rozdělenou na dvě symetrické části po 64 řádcích a 128 sloupcích. Paměťová buňka jednotranzistorová s paměťovou kapacitou. Paměť vyžaduje obnovení informace vždy po 2 ms činnosti a to 128 cykly čtení nebo prázdnými cykly. Výstup třístavový.	IO—14A IO—18/C
MHB8608	Statická paměť NMOS PROM 1024 × 8 bitů naprogramovaná výrobcem. Vstupy a výstupy jsou plně slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem pro výběr obvodu CS.	IO—15/1
MHB8708C	Programovatelná paměť NMOS EPROM 1024 × 8 bitů s možností mazání obsahu paměti ultrafialovým světlem s vlnovou délkou max. 0,4 μm. Dávka energie pro mazání min. 15 Wscm ² při zdroji záření 0,2537 μm. Při provozu čtení je funkce obvodu plně statická. Vstupy a výstupy slučitelné s obvody TTL. Výstupy třístavové, aktivují se signálem CS.	IO—15/2

